

**АННОТАЦИЯ**  
к рабочей программе дисциплины  
**Б1.В.13 «Физика полупроводников»**

<b>Направление подготовки</b>	11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
<b>Профиль</b>	«Микроэлектроника и твердотельная электроника»
<b>Квалификация (степень) выпускника:</b>	бакалавр
<b>Форма обучения</b>	очная / заочная
<b>Срок освоения образовательной программы</b>	4 года / 4 года и 11 мес.
<b>Год начала подготовки</b>	2020

**Цель изучения дисциплины:** формирование у студентов научной основы для осознанного и целенаправленного использования физических свойств полупроводников для создания приборов и устройств микро- и наноэлектроники.

**Задачи изучения дисциплины:**

- расширение научного кругозора и эрудиции студентов на базе изучения фундаментальных закономерностей физики полупроводников и освоение способов практического использования свойств полупроводников;
- развитие понимания связи физических свойств полупроводников с параметрами изделий микроэлектроники на базе этих материалов;
- практическое овладение методами теоретического описания физических свойств полупроводников, владение навыками постановки физического эксперимента по изучению основных свойств и параметров полупроводников;
- владение экспериментальными методами контроля свойств полупроводников;
- создание основы для последующего изучения вопросов физики полупроводниковых приборов, включая устройства и приборы наноэлектроники, твердотельной электроники и технологии микро- и наносистем.

**Перечень формируемых компетенций:**

**ПК-7:** способность идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и применения микроэлектронных приборов и устройств.

**Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 3.**

**Форма итогового контроля по дисциплине:** зачет.